令和2年11月10日発行(毎月1回10日発行 第39巻第11号) 通巻467号 ISSN 0286-9659

光技術コーディネートジャーナル

電池×レーザー応用 ーLi電池・全固体Li電池を中心に

^{紫外線の手引き} 新型コロナウイルス禍を契機に, 紫外線光デバイスの次なるブレイクスルーを追求へ

(国研)理化学研究所 平山秀樹

光とレーザーの科学技術フェア2020

赤外線フェア/分光フェア/光学薄膜フェア/紫外線フェア/レーザー科学技術フェア オプティクスフェア/可視光・次世代レーザー応用ゾーン

出展各社の見どころ

Photo-Tech News & Report 超高速制御ハイパワーマーカーを開発

4月21日 (水)~23日 (金)

2021年



日本最大級の光関連展示会 OPTICS & PHOTONICS International Exhibition OPTICE 221 特集

電池×レーザー応用—Li電池・全固体Li電池を中心に

全固体リチウム電池と レーザー堆積法

東京工業大学 西尾和記,一杉太郎

はじめに

次世代型蓄電池として期待される全固体リチウム (Li) 電池について、世界中で活発に研究・開発が進められて いる。一見、全固体Li電池と光エレクトロニクスは関係 なさそうであるが、実際には、研究段階において多数の 光エレクトロニクス機器が活用されている。本稿では電 池研究で用いられているレーザーやその周辺機器に焦点 をあてつつ、我々の全固体Li電池作製の取り組みを紹介 する。

全固体Li電池の構造を図1に示す。負極,固体電解質, 正極(LiCoO₂等)の三つの要素から成り,Liイオンは正 極から負極へ(充電),あるいは負極から正極(放電) へ移動する。その際,必ず,固体電解質と電極が形成す る界面を行き来する。全固体Li電池のさらなる高性能化 に向けて,大電流で充放電を可能とすることが極めて重



図1 全固体Li電池の模式図。(a)充電時のLiイオン伝導。(b)放電時 のLiイオン伝導。



図2 (a) 薄膜型全固体Li電池の模式図。(b) 全真空プロセスシステム。 右写真は薄膜電池素子。

要であり、この界面に由来する界面電気抵抗を低減する ことが急務である。この抵抗は、界面近傍におけるLiイ オンや電子の移動現象に起因するため、それら現象を原 子レベルで捉えなければならない。そこで、筆者らは薄 膜型全固体Li電池とエピタキシャル薄膜作製技術を活用 している。薄膜型全固体Li電池は、各電池部材を積層し た構成のため、界面構造を単純化できる(図2(a))。さ らに、薄膜電極を原子レベルで平坦かつ結晶方位を制御 することにより、界面におけるLiイオン伝導経路を規定 することができる。これにより、界面現象を定量的に探 るための理想的なモデル系が構築できる。このような薄 膜型全固体Li電池を作製するために、薄膜作製にレーザ ー技術が活用されている。

2 薄膜型全固体Li電池の作製と評価

固体電解質と電極が形成する界面に不純物が存在する

と、界面抵抗を大きくしてしまう可能性がある。したが って、不純物を排除するため、高真空環境下のもと薄膜 型全固体Li電池を作製し、電池特性を評価することが要 求される。そこで、真空環境下で薄膜電池素子の作製か ら電池特性評価まで行うシステムを構築した¹⁾。これに より、一度も大気曝露することなく電池素子が作製でき、 薄膜表面が不純物に汚染されることなく清浄界面を形成 できる。図2(b)に全真空プロセスシステムの模式図を 示す。このシステムは1×10⁻⁶ Pa以下の高真空環境が維 持されているため、各電池部材の薄膜作製プロセス及び 試料搬送時に清浄界面を形成・維持できる。

3 パルスレーザー堆積法による正極薄膜作製

パルスレーザー堆積法 (PLD法) は、高融点な酸化物 系材料を容易にアブレーションできるため、Liイオン二 次電池で利用されている電極材料や固体電解質材料の薄 膜試料作製に適している。原子レベルで平坦、かつ結晶 方位が制御された正極薄膜を作製するにはエピタキシャ ル薄膜作製技術を活用する。様々な薄膜作製法がある中、 筆者らはPLD法を採用している。図3(a)にPLD法の模 式図を示す。PLD法は、高真空チャンバー内に用意した 高密度固体ターゲット表面に、紫外領域の高強度短パル スレーザーを集光してターゲット表面を瞬時に気化・蒸 発(アブレーション)し、対向する基板上に蒸発種の原 子を堆積して薄膜を得る手法である。パルスレーザーと して、エキシマやYAGレーザーが一般的に用いられて



図3 (a) パルスレーザー堆積法の模式図。(b) エピタキシャル薄膜成 長の模式図。

おり、本研究ではKrF(波長248 nm)によりアブレーシ ヨンを行った。

光路を詳細に説明する。短パルスレーザー光(~20 ナノ秒幅)は、高真空チャンバー外に設置された装置か らチャンバー内に置かれたターゲットにレーザー照射す るよう、チャンバー外にミラーを置き、光路を調整する。 レーザー光は紫外領域を透過できる合成石英の入射窓を 通じて高真空チャンバー内に導入される。PLD法では、 レーザー光強度が電池材料の膜質に大きな影響を及ぼす ので、バリアブルアッテネーターでレーザー光強度を調 整し、さらに、アパーチャーによってレーザー照射面積 とレーザーエネルギー分布を規定する。そして、チャン バー外に置いた集光レンズでターゲット上に集光する。 事前に計測した集光面積を用いて、フルエンス(レーザ ーエネルギー÷ターゲット上の照射面積)(Jcm⁻²)に換 算し、レーザー光強度を規定する。一般に、薄膜成長時 にターゲットから飛来する蒸発種がレーザー入射窓に堆 積し、その入射窓のレーザー透過率が変化してしまう。 したがって、薄膜成長開始前に入射窓の透過率を考慮し たうえでエネルギー値を測定しておく必要がある。その ため、ターゲットを光路外まで移動し、高真空チャンバ ーを通り抜けて出てくるレーザー光のエネルギーを測定 する。レーザー光強度は薄膜品質に大きな影響を与える ため. しっかりと計測しなければならない²⁾。

レーザー光がターゲット表面に照射されると、アプレ ーションが起き、薄膜を成長する基板表面に原子が供給 される。アプレーションが起きる時に、ターゲット表面 からプルームと呼ばれるプラズマ発光柱が発生する。こ のプルームの向きを、対向する基板方向に向かせること により、薄膜の品質ムラを抑制できる。プルームの傾き が発生しないよう、成膜中はターゲットを自転させ、均 ーにターゲット表面をアプレーションできるようにして ある。

結晶性薄膜を得るためには、薄膜成長用基板を加熱す る必要がある。その際、基板裏面の基板ホルダーに赤外 線レーザー(Nd:YAG半導体レーザー:波長1064 nm) を照射する。そのために基板ホルダーをステンレス鋼や ニッケルとして、大気中で加熱することによって基板ホ ルダー表面を酸化し、光吸収効率を上げている³⁾。基板

特集 電池×レーザー応用—Li電池・全固体Li電池を中心に

の温度は,放射温度計にて測定している。結晶方位を制 御したエピタキシャル薄膜を作製する場合は単結晶基板 を利用する。その際,基板結晶面や,基板と薄膜材料の 格子整合性を考慮する(図3(b))。

電池材料薄膜を作製する際に難しい点は、金属イオン の酸化数を制御することである。その調整のため、成膜 中に酸素ガスを導入する。特に、Liイオン二次電池の電 極材料のなかで遷移金属を含有しているものには、所望 の酸化状態を得るために意図的に高い酸素雰囲気圧力下 (~13 Pa)のもと薄膜合成を行うこともある⁴⁻⁷⁾。

以上から,定量的な研究に適した薄膜モデル電極を得 ることが可能である。原子レベルで平坦な高品質エピタ キシャル酸化物薄膜を得るためには,パルスレーザーの フルエンス,基板温度,酸素ガス圧力等の組み合わせと なる製膜条件を,それぞれの電極材料に応じて最適化す る必要がある。

4 パルスレーザー堆積法による固体電解質 薄膜作製

固体電解質の場合,ArF(波長193 nm)エキシマレー ザーを利用する。この理由を、固体電解質薄膜として利 用される非晶質Li₃PO₄に着目して説明する。非晶質 Li₃PO₄薄膜は、Li金属や起電力の高いLiCoO₂などの電極 材料に対して高い電気化学的安定性を有しているために 薄膜型全固体Li電池に利用されている。高い電気化学的 安定性を示すためには、電子伝導のないワイドバンドギ ャップ絶縁体(>5 eV)でなければならない。そのため、 波長の長い、つまり、フォトンエネルギーが小さいレー ザー光では、その光を吸収することができず、良好にア ブレーションできなくなる。実際に、KrFエキシマレー ザーや4倍波のNd:YAGレーザー(波長266 nm)等を用 いた場合、非晶質Li₃PO₄薄膜は固体電解質としての性能 が劣化してしまう。しかし、ArFエキシマレーザーを利 用すると、緻密な膜が形成され、非晶質Li₃PO₄薄膜が固 体電解質として機能する^{8,9)}。特に重要な指標はLiイオン 伝導度であり、5×10⁻⁷S cm⁻¹程度が再現性よく得られる。

5 エピタキシャル薄膜の合成例

5.1 LiCoO。エピタキシャル薄膜

以下、PLD法で作製するエピタキシャル薄膜電極の例 を示す。まず、LiCoO₂エピタキシャル薄膜の合成例を示 す。LiCoO₂(格子定数a=0.2816 nm. c=1.4052 nm)は 層状岩塩型構造を有しており、LiとCoが層状に秩序し た構造を有している(図4(a))。そのため、Liイオン伝 導に結晶異方性がある。単結晶基板としてAl₂O₃(0001) (コランダム構造、格子定数a=0.47588 nm. c=1.2992 nm)を利用すると、LiCoO₂(001)配向する。図4(b) に透過型電子顕微鏡像を示す。基板の原子ステップ(高



図4 (a) 層状岩塩型構造LiCoO₂電極材料。(b) Al₂O₃ (0001) 単結晶基板上のLiCoO₂ (001) エピタキシャル薄膜透過電子顕微鏡像。(c) 固体電解質/ LiCoO₃ (001) 界面のLiイオン伝導経路模式図。

さ約0.2 nm) を反映してLi層のずれたLiCoO₂(001) ド メインを形成する(位相反転ドメイン)¹⁰⁾。Liイオン伝 導経路はこのドメイン界面で形成されているものと考え られており(図4(c)), このような界面を有した薄膜電 池素子において高速に充放電できることを筆者らは確認 している¹¹⁾。

5.2 LiNi_{1/3}Mn_{1/3}Co_{1/3}O₂エピタキシャル薄膜

次に. 実電池型の正極材料として知られる LiNi_{ua}Mn_{ua}Co_{ua}O₂ (NMC)のエピタキシャル薄膜に関し て述べる。NMCはLiCoO,と同じ層状岩塩型構造を有し ており、CoサイトをCo, Ni, Mnで均等に置換した固溶 体であり、LiCoO,と比較して高容量、高エネルギー密度 化された電極材料である¹²⁾。このNMC(格子定数 a=0.2862 nm. c=1.4227 nm) ならびに同じ層状岩塩型構 造は、SrTiO,単結晶基板を利用することによって結晶方 位を制御してエピタキシャル薄膜成長できる。図5(a) にNMCとSrTiO,のエピタキシャル関係を示す。SrTiO, は格子定数0.3905 nmのペロブスカイト構造を有してい る。層状岩塩型構造NMCは酸化物イオンが面心格子を 形成している。この酸化物イオンの配列と、SrTiO,の酸 化物イオンの配列の類似性を反映してNMCはエピタキ シャル薄膜成長する。例えば、SrTiO,(001)上にNMC 薄膜作製するとNMC(104) 面が成長し¹³⁾, SrTiO₃(111) であればNMC (001) 面が成長する⁷⁾。



図5 (a) 層状岩塩型構造LiNi_{1/3}Mn_{1/3}Co_{1/3}O₂ (NMC) とペロブスカイ ト型構造SrTiO₃のエピタキシャル関係。(b) スピネル型構造 LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O₄ (LNMO) とSrTiO₃のエピタキシャル関係。

5.3 スピネル型構造LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O₄エピタキシャル 薄膜

次に、LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O₄ (LNMO) 電極材料に関して述べる。 LNMOはLiイオンの脱離/挿入に伴う充放電時にNi^{2+/4+} の酸化/還元反応が起き,平均電圧4.7 V vs. Li/Li⁺の高 い起電力が特徴的な電極材料である¹⁴⁾。そのため、より 大きな出力を出す電池につながり、実用化が期待されて いる。

LNMOはスピネル型構造を有しており,格子定数 0.81733 nmの立方晶である。LNMOもSrTiO₃単結晶基板 を利用すると,配向制御されたエピタキシャル薄膜成長 が可能である。格子定数の観点からすれば,LNMOは SrTiO₃のおよそ2倍にも及ぶ大きな結晶格子ではあるが, スピネル型構造は酸化物イオンが面心立方格子を形成し ており,酸化物イオンの配列にSrTiO₃との類似性を有し ている。つまり,LNMOとSrTiO₃上において図5(b)に 示すようにcube-on-cubeの関係が成立するためにエピタ キシャル薄膜成長する。

6 全固体Li電池における固体電解質/電極 界面抵抗の定量的評価

前述したエピタキシャル薄膜電極を利用して清浄界面 を有する薄膜型全固体Li電池を作製すると、固体電解質 と電極が形成する界面の抵抗は極めて低いことを我々は 明らかにしてきた。例えば、Li,PO₄/LiCoO,(001)の界 面抵抗は~5.5 Ωcm²¹⁵⁾を示した。この界面抵抗値は、こ れまでに報告されている全固体Li電池における値のおよ そ40倍も小さい。さらに、Li,PO,/NMC(001)は10.2 Ωcm²⁷⁾, Li₂PO₂/NMC (104) は 5.2 Ωcm²¹³⁾ と、両結晶 方位で界面抵抗は極めて低く, さらに, 界面抵抗に結晶 方位依存性があることも明らかとなった。同様にして, $Li_{2}PO_{4}/LNMO$ (111) $l_{2}^{2}36 \Omega cm^{25}$, $Li_{2}PO_{4}/LNMO$ (100) は7.6 Ωcm²⁴⁾のように、LNMO 正極においても結晶方位 に応じて界面抵抗値に差がみられた。このように、電極 の結晶方位を規定したエピタキシャル薄膜電極を活用す ることで、界面におけるLiイオン伝導経路と界面抵抗の 関係を定量的に明らかにしてきた。さらに、これらの界 面抵抗値は,液体電解質を用いたリチウムイオン電池の

界面抵抗(~25 Ωcm²)よりも低い¹¹⁾。つまり,全固体 Li電池は,極めて低抵抗な界面抵抗が実現できることを 実証した。

おわりに

光エレクトロニクス機器が電池研究に活用されている 例を述べた。PLD 法によるエピタキシャル薄膜作製技術 を活用し、全固体Li電池の本質的な課題を解決する研究 例を紹介した。本研究ではPLD法においてKrFエキシマ レーザーを利用しているが、最近では、Nd:YAG レーザ ーが安定化されてきており、4倍波(波長266 nm)を利 用した酸化物エピタキシャル薄膜成長を筆者らは報告し ている¹⁶⁾。このNd:YAGレーザーの5倍波(波長213 nm) を用いれば、固体電解質も成膜できると期待される。そ の他,実際に電池研究においては、光学顕微鏡やレーザ ー顕微鏡, FT-IR, ラマン分光など, 構造評価の面で多 用されている。また、電池反応中における電極材料の分 子・電子状態を理解するという観点で、反射・透過スペ クトル, テラヘルツ波分光, 多光子吸収分光や超高速分 光などが適用されつつある。以上、本稿で述べたように、 物質合成から電池反応過程の計測まで多岐に渡る領域に おいて、ますます光エレクトロニクス機器が使われるこ とと考えられる。

謝辞。」「「」」「」」「」」「」」」」」」」」」」」」

本研究は、トヨタ自動車㈱、JST-CREST、科研費 基盤 研究(A)、若手研究の支援を受けて行われた。この場を 借りて深く感謝を申し上げたい。

参考文献

- 1) M. Haruta, T. Hitosugi et al., Solid State Ion. 285, 118-121 (2016).
- 2) T. Ohnishi et al., Appl. Surf. Sci. 252, 2466-2471 (2006).
- 3) S. Ohashi et al., Rev. Sci. Instrum. 70, 178 (1999).
- H. Kawasoko, H. Hitosugi *et al.*, ACS Appl. Mater. Interfaces, 10, 27498-27502 (2018).
- H. Kawasoko, T. Hitosugi *et al.*, ACS Appl. Energy Mater. 3, 1358-1363 (2020).
- 6) K. Nishio, T. Hitosugi et al., J. Power Sources, 416, 56-61 (2019).
- 7) K. Nishio, T. Hitosugi et al., Appl. Phys. Lett. 116, 053901 (2020).
- 8) N. Kuwata, et al., J. Electrochem. Soc. 16, 53-60 (2009).
- 9) N. Kuwata et al., J. Electrochem. Soc. 157, A521-A527 (2010).
- 10) S. J. Zheng, T. Hitosugi et al., Acta Materialia, 61, 7671-7678 (2013).
- 11) M. Haruta, T. Hitosugi et al., Nano Lett. 15, 1498-1502 (2015).
- 12) N. Yabuuchi et al., J. Power Sources, 119-121, 171-174 (2003).
- K. Nishio, T. Hitosugi et al., ACS Appl. Energy Mater. 3, 6416-6421 (2020).
- 14) Q. Zhong et al., J. Electrochem. Soc. 144, 205-213 (1997).
- 15) S. Shiraki, T. Hitosugi *et al.*, ACS Appl. Mater. Interfaces, **10**, 41732-41737 (2018).
- 16) R. Shimizu, T. Hitosugi et al., AIP Adv. 8, 095101 (2018).

Solid-state Li batteries and laser deposition technique

Kazunori Nishio 2 Taro Hitosugi

■①Specially-appointed Assistant Professor, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology ②Professor, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology

①ニシオ カズノリ
所属:東京工業大学 物質理工学院 特任助教
②ヒトスギ タロウ
所属:東京工業大学 物質理工学院 教授

